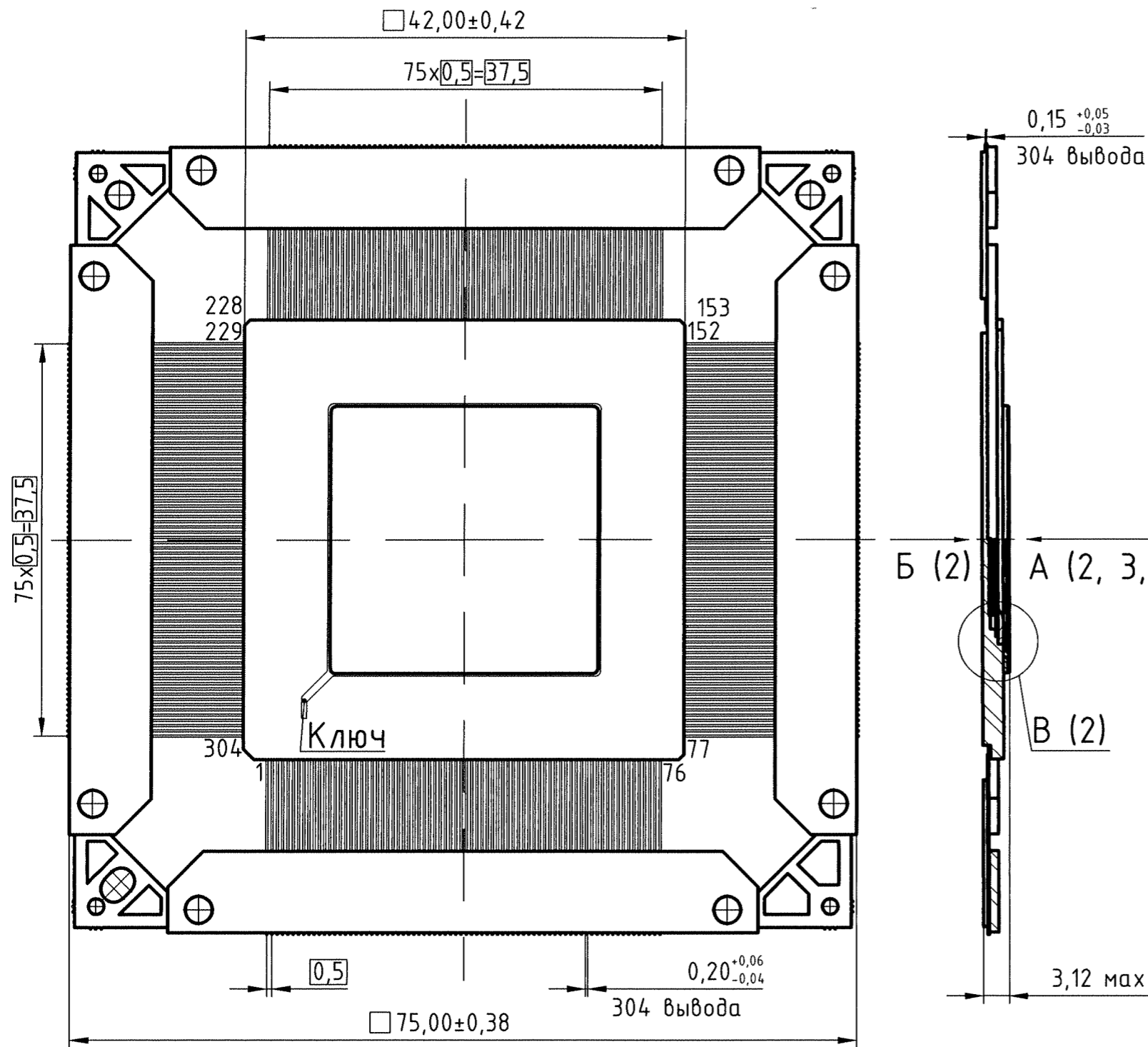


Г АВЛ.431268.020СБ

Рис.1 (Г АВЛ.431268.020)

(см. продолжение на листах 2, 3, 4)



1. Размеры для справок.
2. Кристалл поз.1 клеить к основанию корпуса поз.2 клеем ТОК2 ШКФЛО.028.002ТУ в соответствии с требованиями технологической документации. Не допускается попадание клея на лицевую поверхность кристалла и контактные площадки основания корпуса.
3. Разварку алюминиевой проволоки поз.3 между контактными площадками кристалла и траверсами корпуса производить методом ультразвуковой сварки по РД 11 0274. Не допускается касание проволочным проводником открытых участков кристалла и основания корпуса.
4. Минимальное расстояние между проволочными межсоединениями и незащищенными участками поверхности кристалла должна быть не менее диаметра развариваемой проволоки. Величина Г - максимальная стрела прогиба проводника.
5. Герметизацию корпуса производить методом шовной контактной сварки по РД 11 0274. При этом допускается смещение крышки в пределах ободка основания и наплыв металла по контуру крышки.
6. Показатель герметичности по эквивалентному нормализованному потоку должен быть не более  $6,65 \cdot 10^{-3} \text{ Па} \cdot \text{см}^3 / \text{с}$ .
7. Внешний вид микросхем должен соответствовать описанию образцов внешнего вида Г АВЛ.431269.045Д2.
8. Маркировать составом маркировочным эпоксидным черным МКЭЧ-1 РМ11.028.002-83 по ОСТ В 11 0998 Дк, Шк, Нк, ОП, регистрационный номер карты заказа шрифтом ПО-1,5 по ОСТ 11 010.012-74, Тк, Кк, знак Δ согласно виду А для микросхемы 5529ТР094 и согласно виду Д для микросхемы 5529ТР094А. Допускается использовать состав маркировочный эпоксидный черный МКЭЧ РМ11.028.002-83.
9. Допускается маркировка крышки методом лазерной гравировки на глубину не более 1,5 мкм и маркировка основания корпуса методом лазерной гравировки на глубину не более 30 мкм.
10. С обратной стороны маркировать согласно виду Б для микросхемы 5529ТР094, виду Е для 5529ТР094А.
11. Дк маркировать четырьмя цифрами: две первые цифры обозначают год изготовления (последние две цифры года); две вторые цифры обозначают календарную неделю года.
12. Δ - знак чувствительности к статическому электричеству, равносторонний треугольник.
13. В зоне Шк маркировать согласно таблице 1.
14. Микросхемы опытных партий дополнительно маркируются клеймом ОП.
15. Допускается нанесение клейма ВП и клейма ОП производить одновременно с маркировкой микросхемы.
16. Нумерация выводов приведена условно.

16. Общее содержание драгметаллов в готовом изделии 5529ТР094 соответствует данным этикетки Г АВЛ.431268.020ЗТ, 5529ТР094А - Г АВЛ.431268.020-01ЗТ.
17. Исполнения микросхем приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Модификация

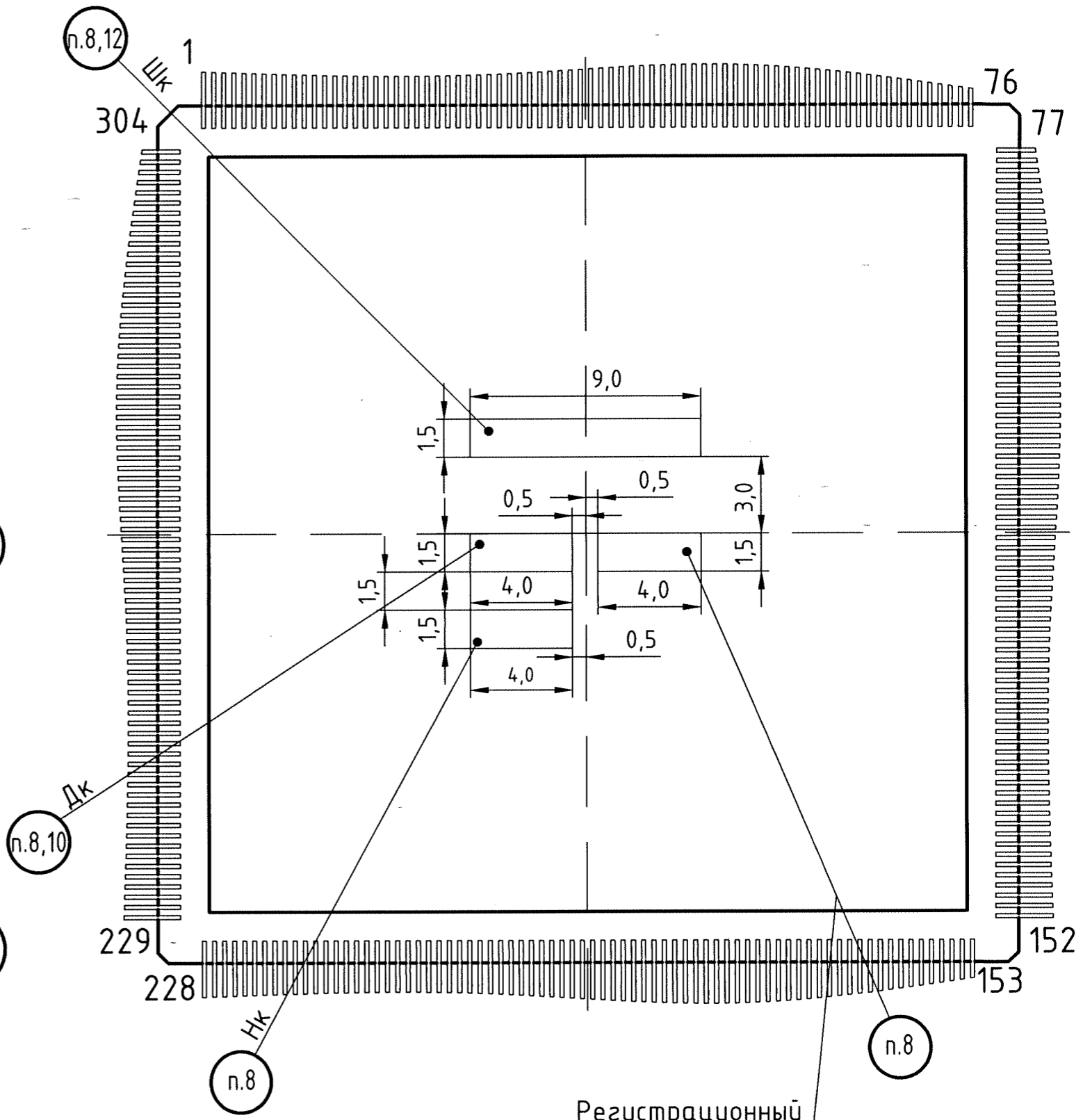
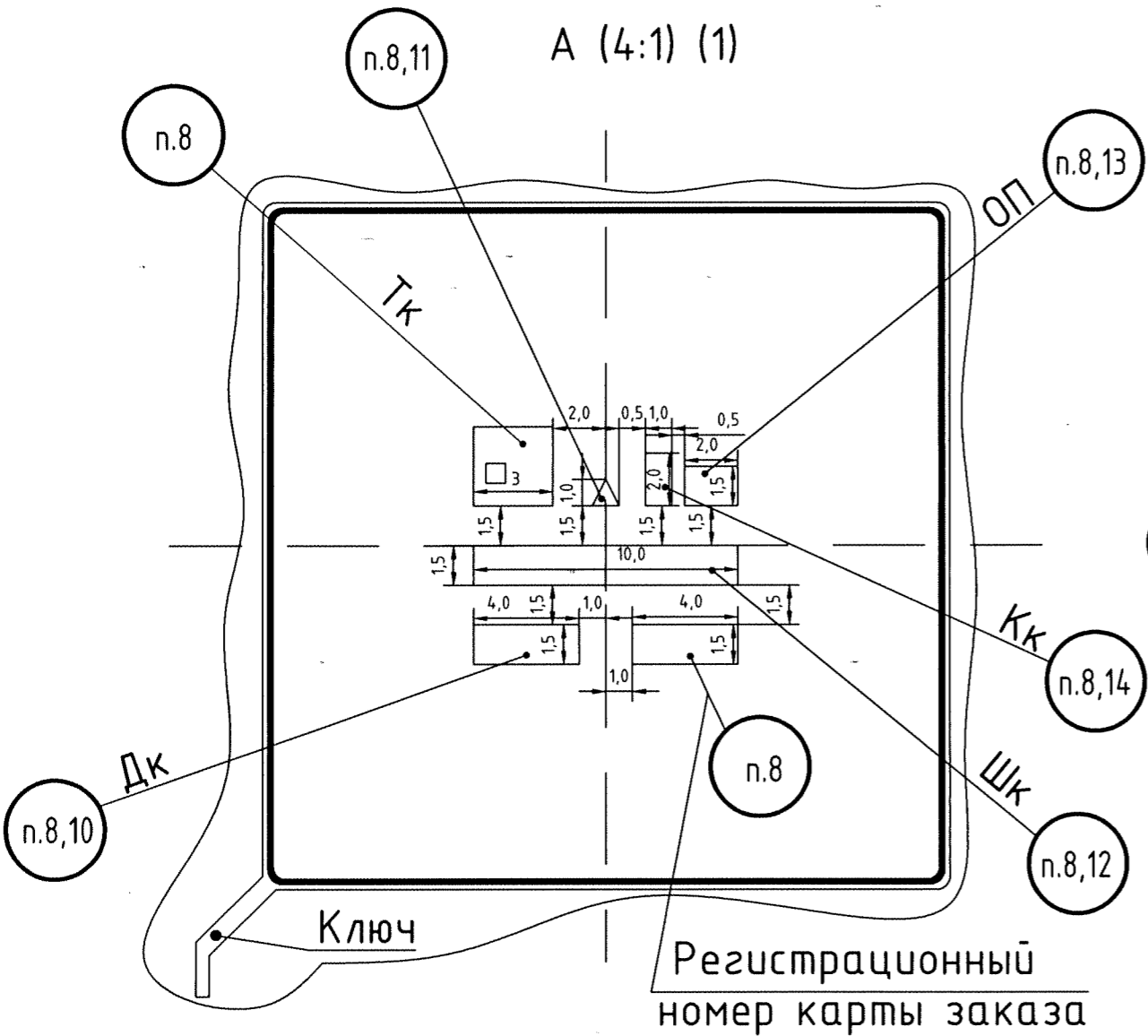
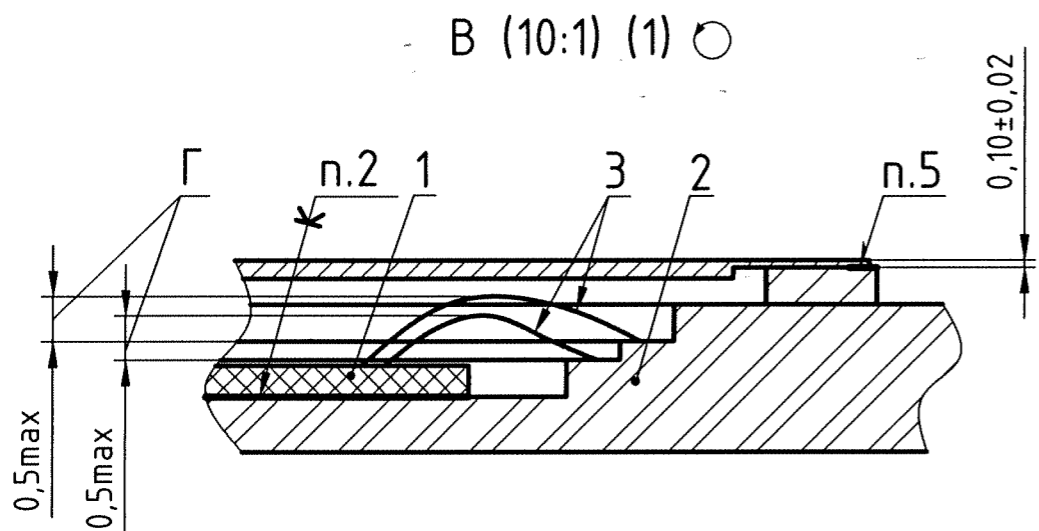
Обозначение	Наименование изделия	Корпус	Маркировка Шк	Масса	Рис.
Г АВЛ.431268.020	5529ТР094	МК 4251.304-2	5529ТР094	max 23,0 г	1
-01	5529ТР094А	МК 4244.256-4	5529ТР094А	max 20,0 г	2

Г АВЛ.431268.020СБ					
1	Зам.	Г АВЛ.09-2019	Подп.	Дата	Лит.
Изм/Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	Микросхемы интегральные 5529ТР094, 5529ТР094А Сборочный чертеж	
Разраб.	Астахова	Подп.	13.11.19	А	Масса - Масштаб 2:1
Пров.	Тукашкин	Подп.	13.11.19	Лист 1 / Листов 8	
512 ВП	Чириченко	Подп.	13.12.19		
Н.контр.	Казаков	Подп.	13.11.19		
Утв.	Денисов	Подп.	13.11.19		

Перв. примен. Г АВЛ.431268.020  
Справ. №  
Взам. инв. № Инв. № дцбл  
Подп. и дата  
Инв. № подл. 1604

Рис.1 (продолжение)  
(ГВЛ.431268.020)

Б (4:1) (1) ○

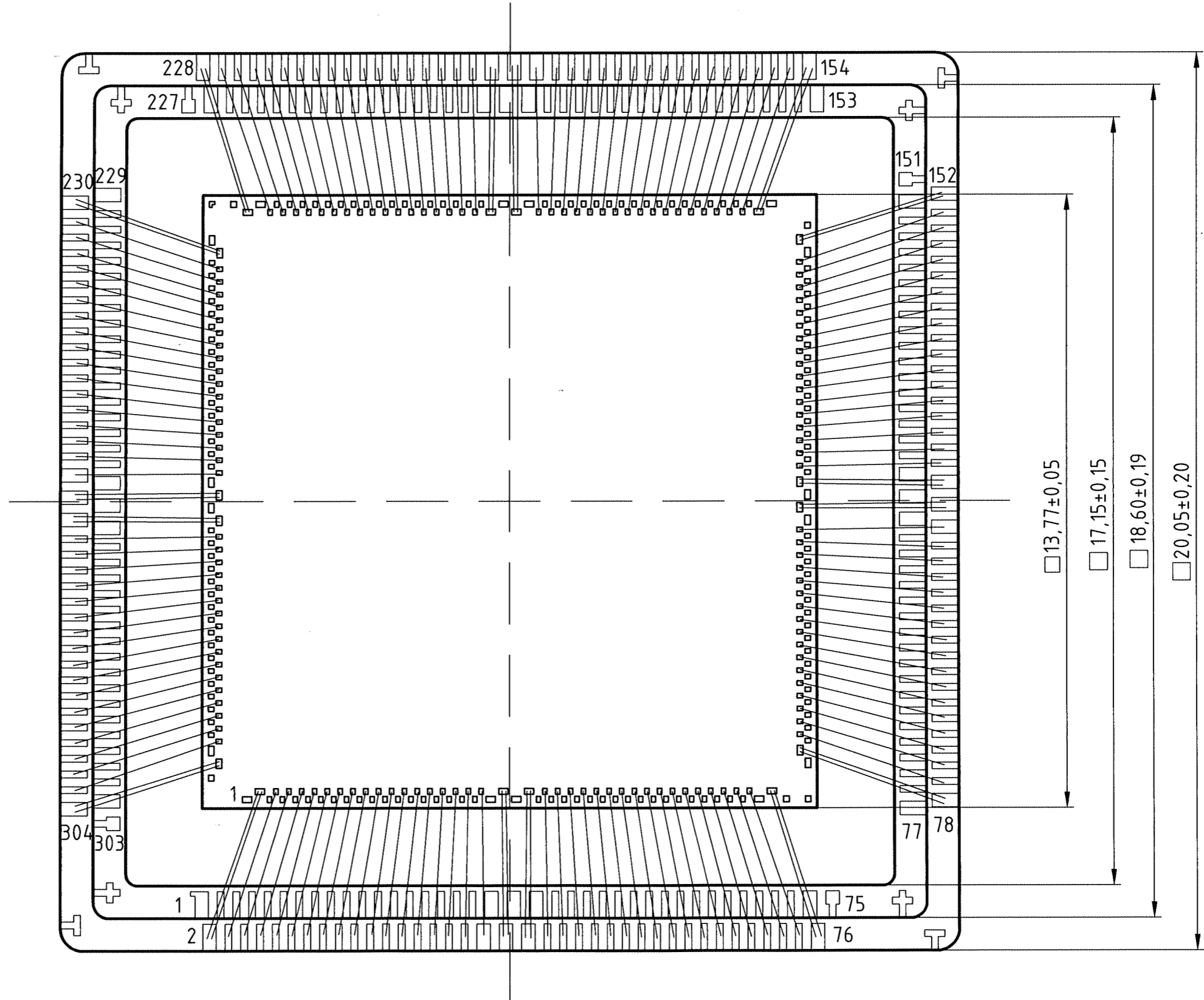


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1601	Сыт. 22.01.20.			

1	Зам.	ГВЛ.09-2019	Сыт	22.01.20
Изм/Лист	Докум.	Подп.	Дата	

Рис.1 (продолжение)  
 (Г АВЛ.431268.020)  
 А (10:1) (1)

Крышка и внешние выводы микросхемы не показаны, показана разварка на внешние площадки колодца

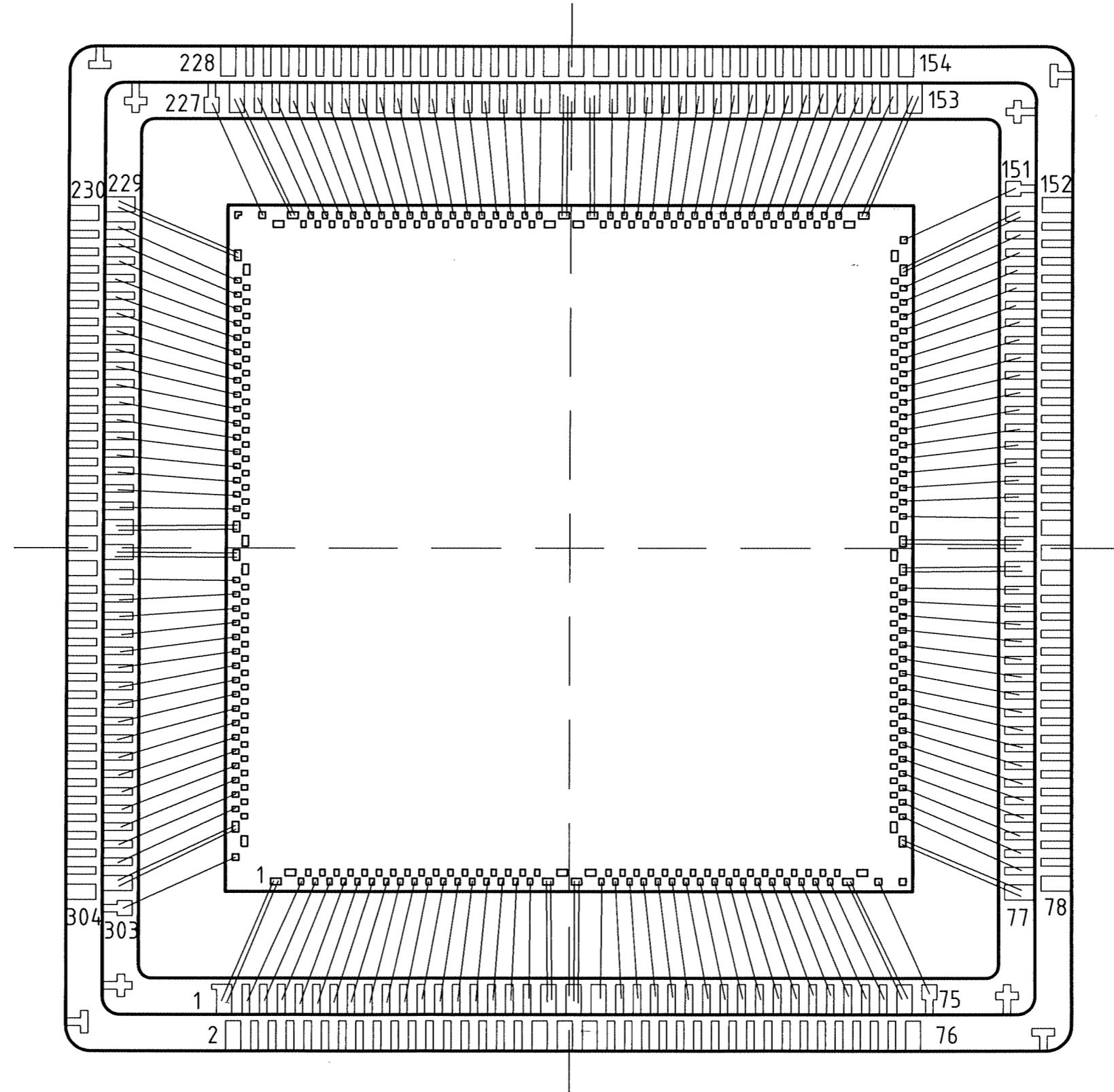


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № докл	Подп. и дата
1601	И.И.И. 01.20			

1	Зам.	Г АВЛ.09-2019	И.И.И.	09.12.19	Г АВЛ.431268.020СБ	Лист
Изм.	Лист	Докум.	Подп.	Дата		3

Рис.1 (продолжение)  
(Г АВЛ.431268.020)  
А (10:1) (1)

Крышка и внешние выводы микросхемы не показаны, показана разварка на внутренние площадки колодца

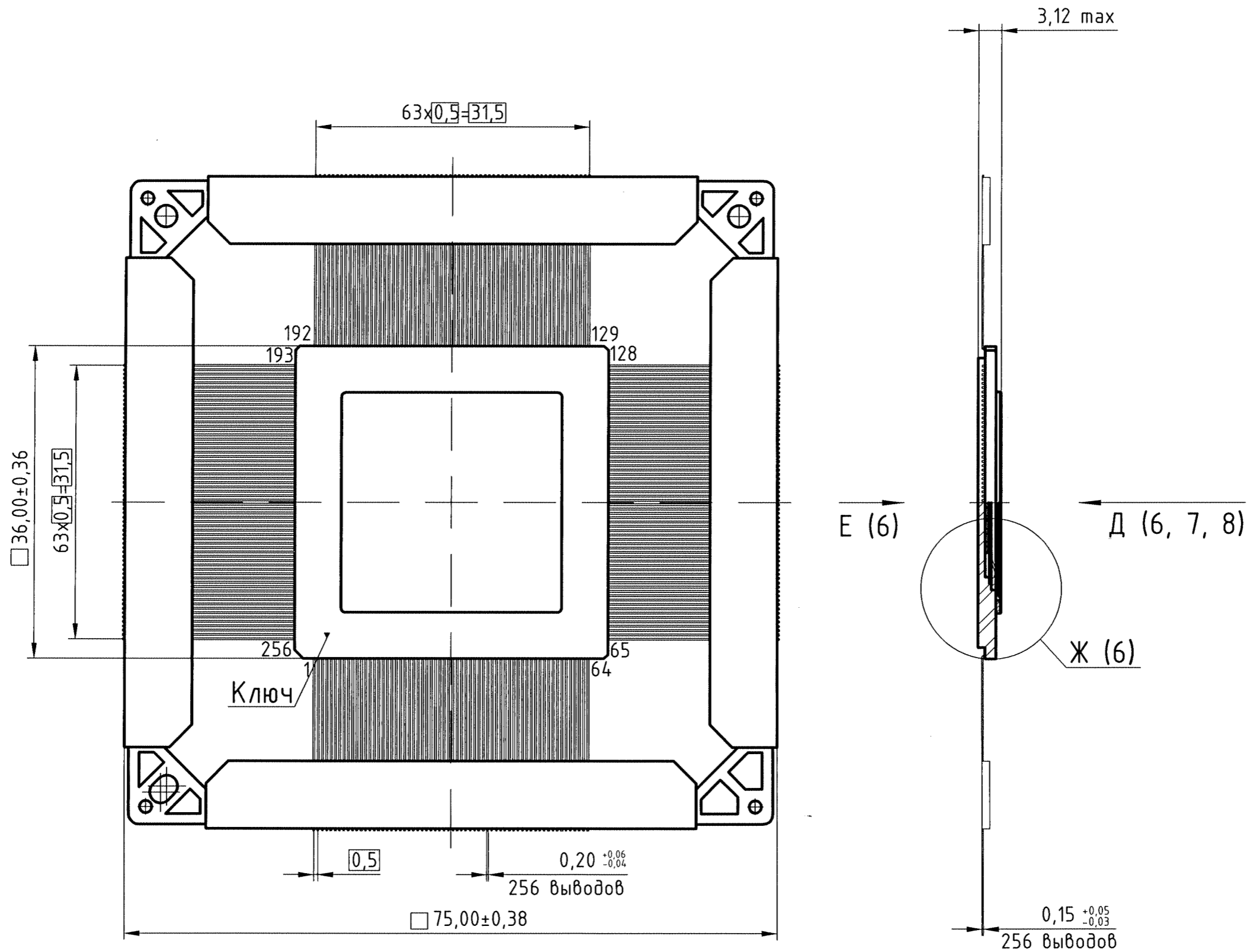


Инв. № подл. 1601	Подп. и дата <i>С.Ф. Ш. Ш.</i>	Взам. инв. № Инв. № дцбл	Подп. и дата
----------------------	-----------------------------------	-----------------------------	--------------

1	Зам.	Г АВЛ.09-2019	<i>С.Ф. Ш. Ш.</i>	05.08.19
Изм./Лист	Докум.	Подп.	Дата	

ГВЛ.431268.020СБ

Рис.2 (ГВЛ.431268.020-01)  
(см. продолжение на листах 6, 7, 8)



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
1601	<i>И.И.И.</i>			

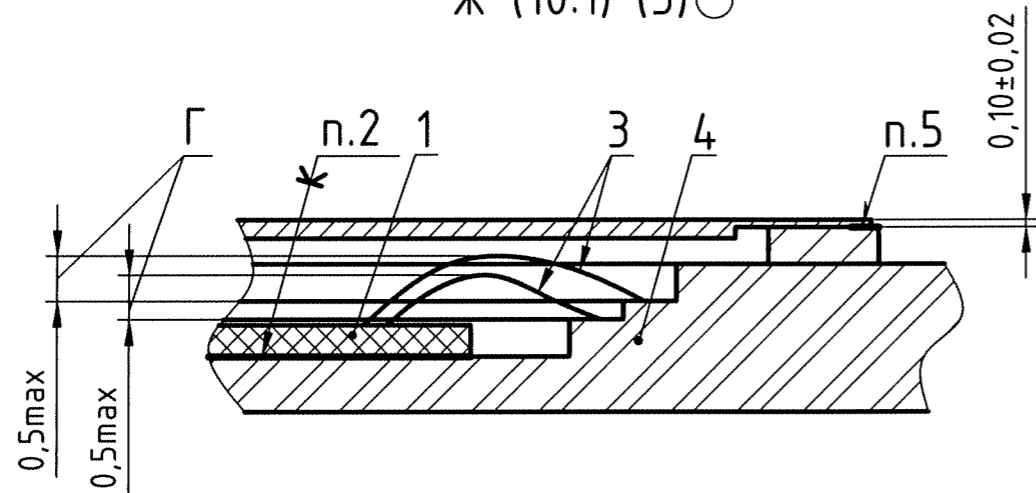
1	Зам.	ГВЛ.09-2019	<i>И.И.И.</i>	29/11/19
Изм./Лист	Докум.	Подп.	Дата	

ГВЛ.431268.020СБ

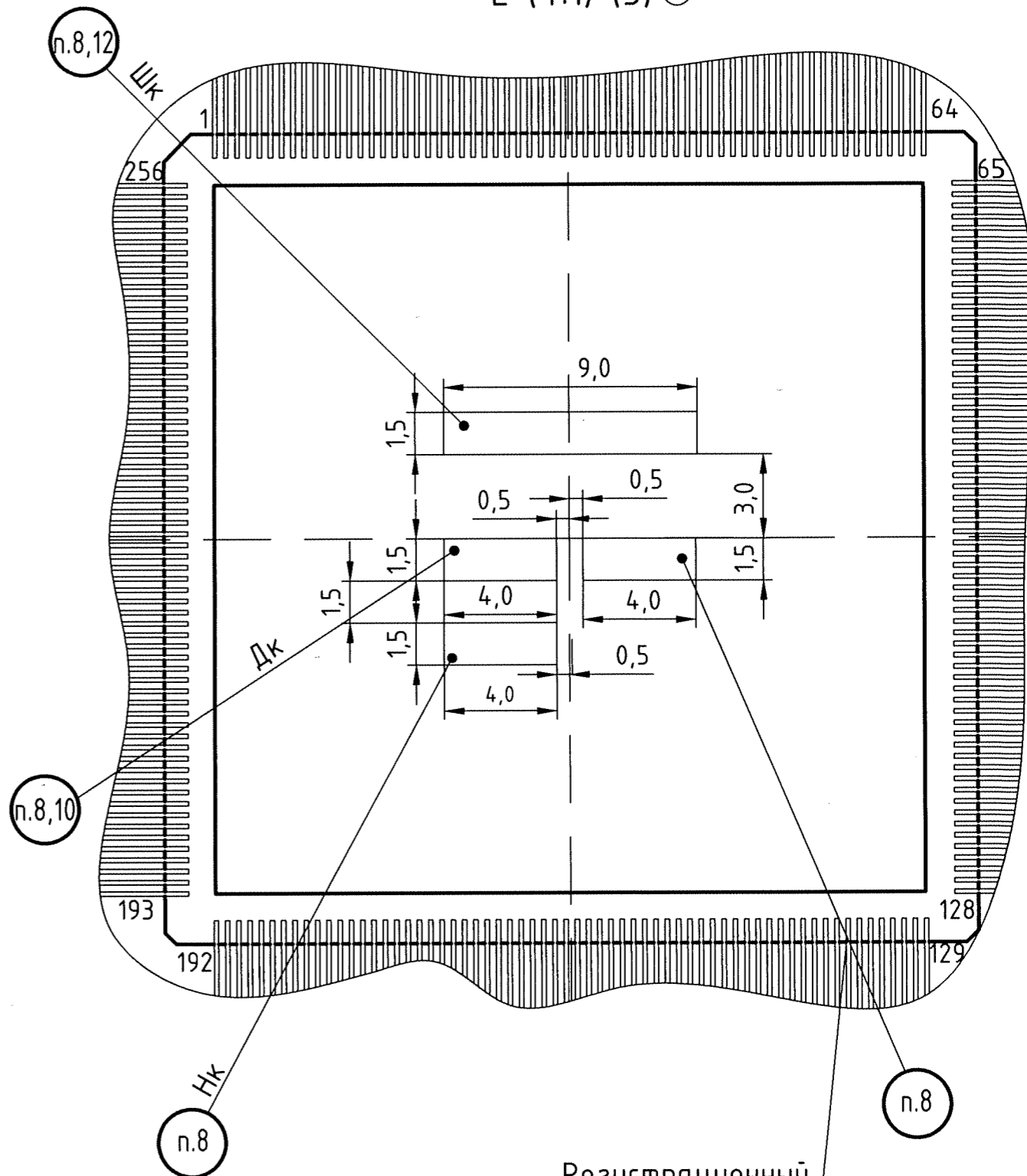
Лист  
5

Рис.2 (продолжение)  
(ГВЛ.431268.020-01)

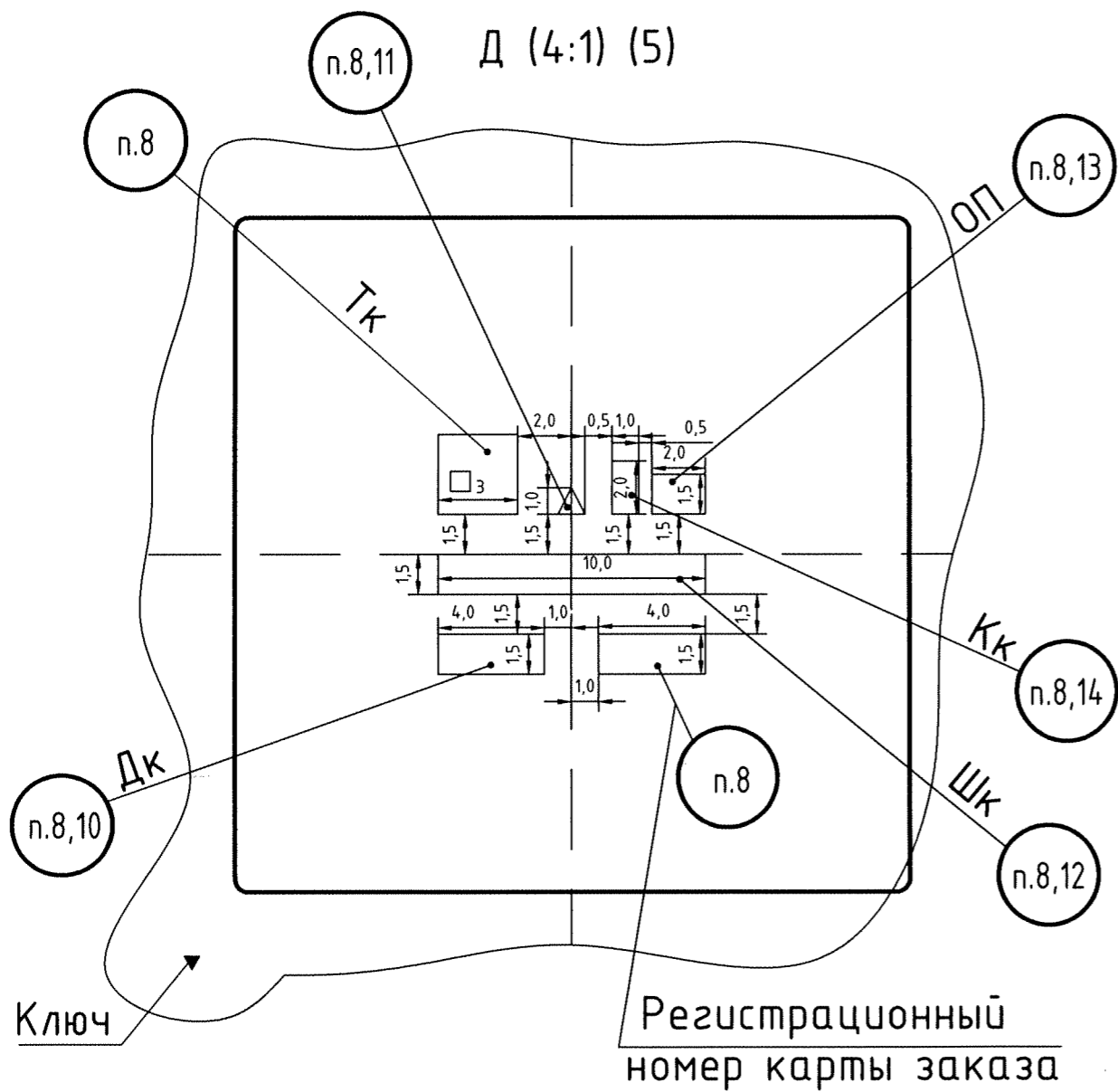
Ж (10:1) (5) ○



Е (4:1) (5) ○



Д (4:1) (5)



Регистрационный  
номер карты заказа

Регистрационный  
номер карты заказа

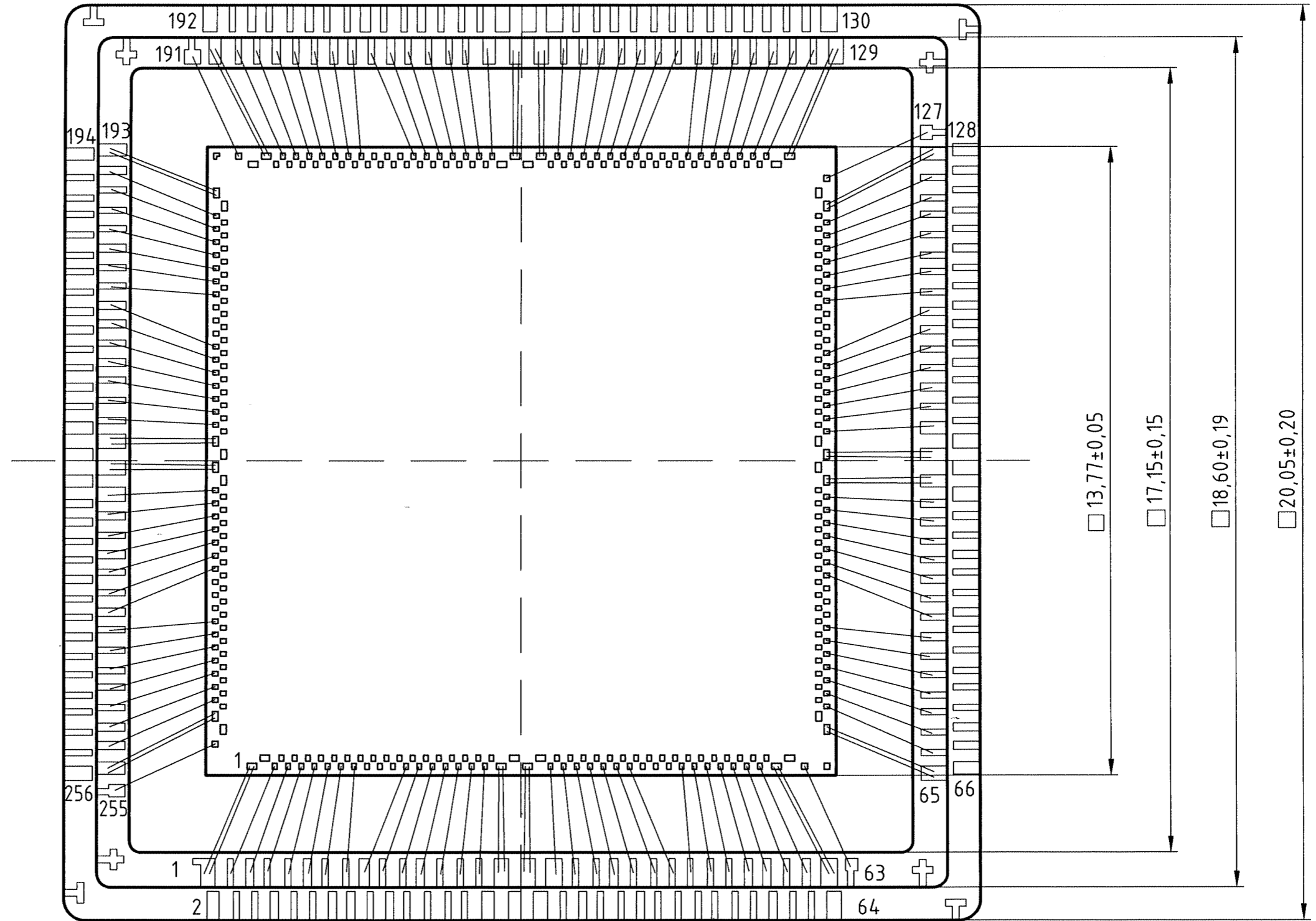
Инв. № подл. 7601	Подп. и дата Сид. А.А. 01.08	Взам. инв. № Инв. № дцбл	Подп. и дата
----------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------

1	Зам.	ГВЛ.09-2019	Сид	02.08
Изм/Лист	Докум.	Подп.	Дата	

Рис.2 (продолжение)  
(Г АВЛ.431268.020-01)

Д (10:1) (5)

Крышка и внешние выводы микросхемы не показаны, показана разварка на внутренние площадки колодца

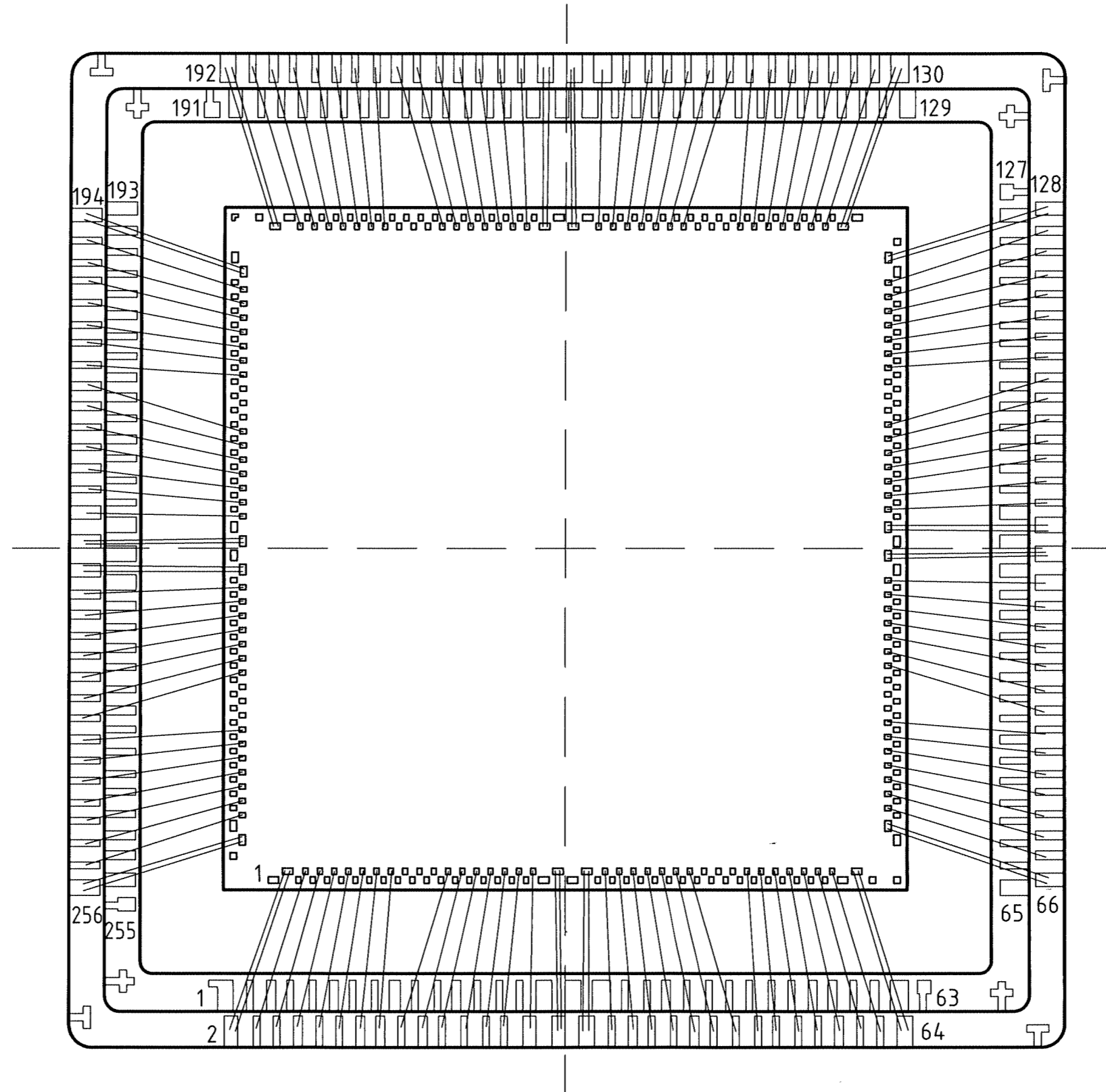


Инв. № подл. 7601	Подп. и дата <i>Иванов</i>	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
----------------------	-------------------------------	--------------	--------------	--------------

1	Зам.	Г АВЛ.09-2019	<i>Иванов</i>	09.19
Изм./Лист	Докум.	Подп.	Дата	

Рис.2 (продолжение)  
 (ГВЛ.431268.020-01)  
 Д (10:1) (5)

Крышка и внешние выводы микросхемы не показаны, показана разварка на внешние площадки колодца



Инв. № подл. 1601	Подп. и дата Лит. 01.20.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
----------------------	-----------------------------	--------------	--------------	--------------

1	Зам.	ГВЛ.09-2019	03.01.19
Изм./Лист	Докум.	Подп.	Дата